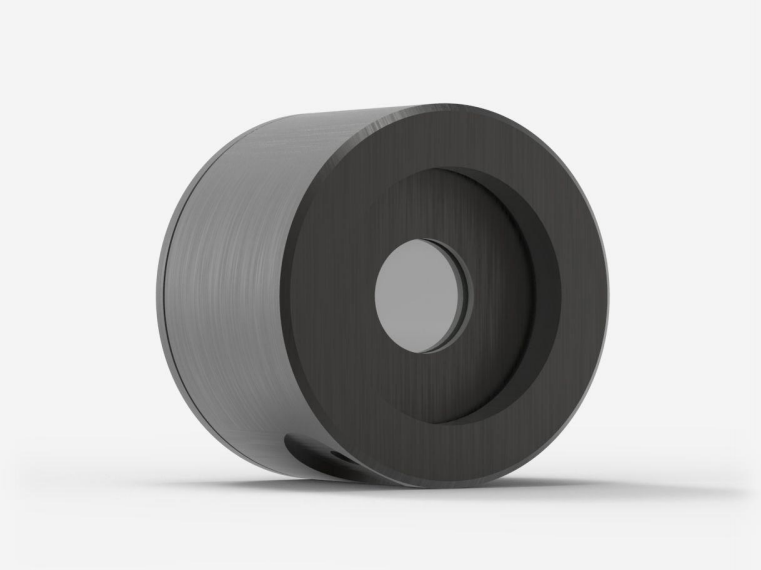
PH100-SIUV-D0

光电二极管探测器的激光功率测量高达 4 mW。



产品系列主要特性

大光圈

硅传感器光圈为10 mm直径

3种型号

- 硅 350 - 1080 nm, 高达750 mW
- 紫外硅 210 - 1080 nm, 高达38 mW
- 锗 800 - 1650 nm, 高达500 mW

衰减器选择

高准确度

全新PH100-Si-HA大幅降低校准不确定因素

准确校准

波长选择 1 nm一格

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

STAND-D-233

规格

测量能力

最大平均功率[1]	4 mW
噪声等效功率[2]	10 pW
光谱范围	210 - 1080 nm
典型升起时间	0.2 s
功率校准不确定性	±18 % (210 - 229 nm) ±8.0 % (230 - 254 nm) ±6.5 % (255 - 399 nm) ±2.5 % (400 - 899 nm) ±4.0 % (900 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
峰值灵敏度	0.45 A/W @ 850 nm
最小重复率[3]	1000 Hz

1. 532 nm。查看其他波长的最大功率曲线。
2. 850 nm。标称值。实际值取决于环境电磁干扰和波长。
3. 详细信息请参阅用户手册。

损坏阈

最大平均功率密度	100 W/cm²

物理特性

孔径	10 mm
吸收器	SiUV
尺寸	38.1Ø x 27.4D mm
重量	0.13 kg
距传感器表面距离	13.7 mm

订购信息

PH100-SiUV-D0	200879
PH100-SiUV-IDR-D0	203231
PH100-SiUV-INT-D0	202788

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表